

СДЕЛАНО В СССР

ТРАНЗИСТОРНЫЕ

МАТРИЦЫ ТИПОВ

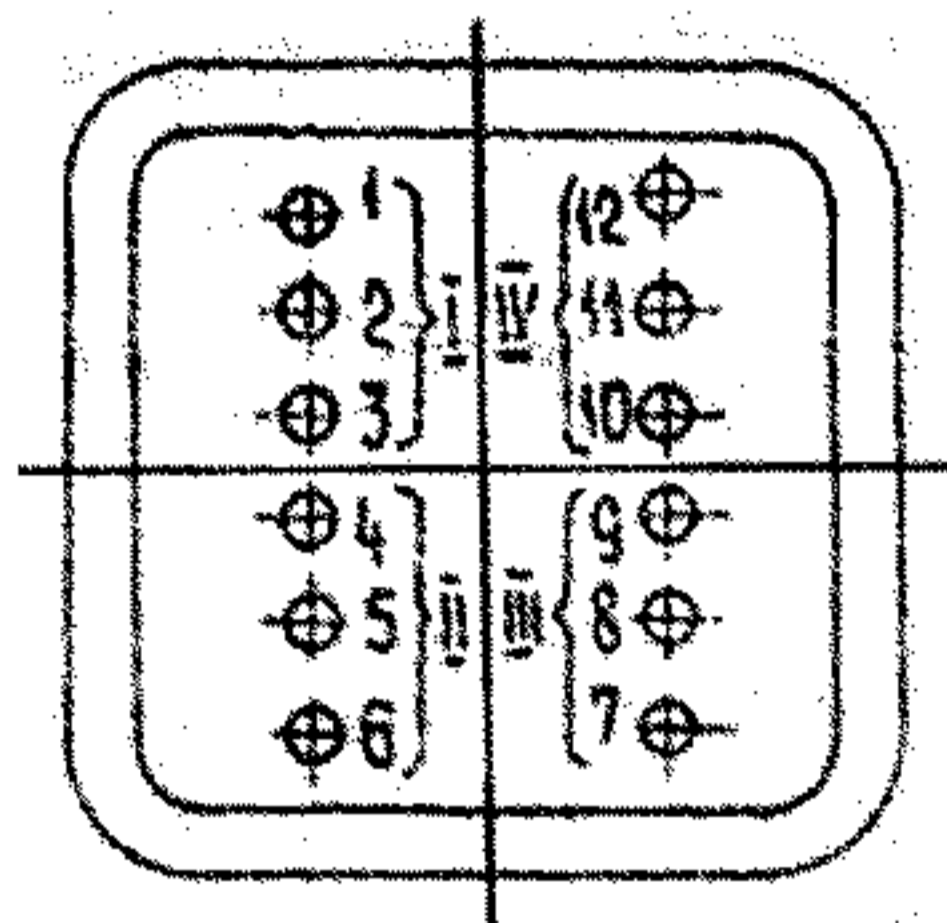
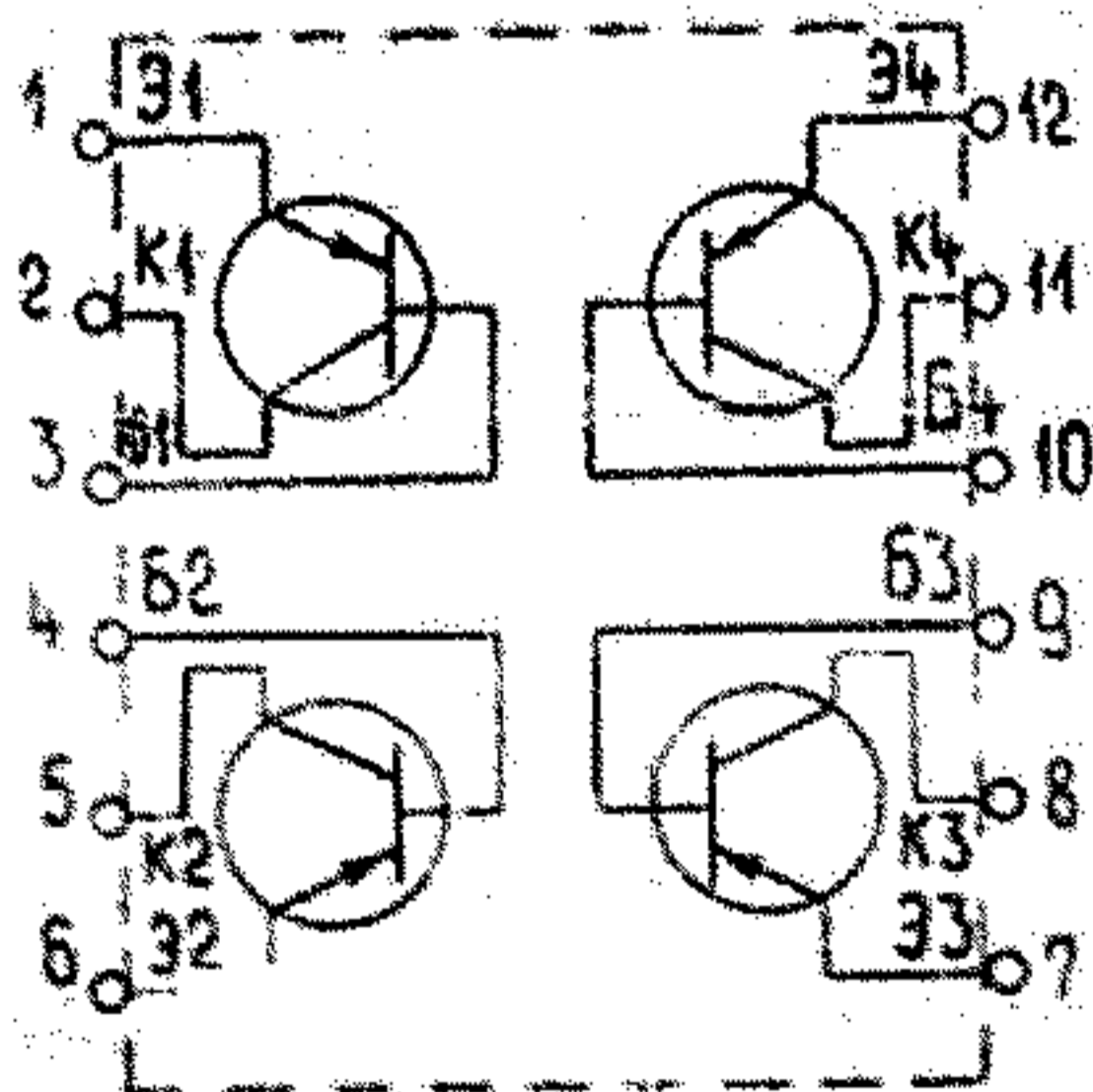
ГТ0609А, ГТ0609Б, ГТ0609В

Заказ-наряд №

84/20297-3851-70020

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Германиевые сплавно-диффузионные р-п-р ВЧ транзисторные матрицы типов ГТ0609А, ГТ0609Б, ГТ0609В, предназначенные для работы в переключающих схемах.



Масса не более 4 г

## 2. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ

2.1. Транзисторные матрицы допускают эксплуатацию в условиях и после воздействия на них следующих механических нагрузок:

- вибрационных нагрузок в диапазоне частот от 1 до 5000 Hz с ускорением  $392 \text{ m/s}^2$  (40 g) - кратковременное воздействие;
- вибрационных нагрузок в диапазоне частот от 1 до 3000 Hz с ускорением  $196 \text{ m/s}^2$  (20 g) - длительное воздействие;
- линейных (центробежных) нагрузок -  $4905 \text{ m/s}^2$  (500 g).

2.2. Транзисторные матрицы допускают эксплуатацию в условиях воздействия на них следующих климатических факторов:

- температуры окружающей среды или другого газа (кроме агрессивного) от 213 до 343 К;
- смены температур от 213 до 343 К;
- относительной влажности воздуха до 98 % при температуре до 308 К без конденсации влаги;
- атмосферного давления от 665 до 297198 Pa.

### 3. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

#### 3.1. Электрические параметры

Наименование параметра	Норма		
	ИТС609А	ИТС609Б	ИТС609В
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером (при напряжении на коллекторе 3 В, токе эмиттера 0,5 А, частоте 1000 Нз и длительности импульса (5-10) мс)	33-100	53-160	40-120
Статический коэффициент передачи тока в схеме с общим эмиттером (при напряжении на коллекторе 3 В, токе эмиттера 0,25 А, частоте 1000 Нз и длительности импульса (5-10) мс), не менее	-	-	60
Обратный ток коллектора, мА (при напряжении на коллекторе 30 В), не более	30	30	30
Обратный ток эмиттера, мА (при напряжении на эмиттере 2,5 В), не более	100	100	100

Наименование параметра	Норма		
	ГТС609А	ГТС609Б	ГТС609В
Напряжение насыщения коллектор-эмиттер, V (при токе коллектора 0,5 А, токе базы для группы А - 70 мА, для групп Б, В - 40 мА, частоте 1000 НЗ длительности импульса 10 мкс), не более	1,6	1,6	1,6
Напряжение насыщения база-эмиттер, V (при токе коллектора 0,5 А, токе базы для группы А - 70 мА, для групп Б, В - 40 мА, частоте 1000 НЗ и длительности импульса 10 мкс), не более	1,1	1,1	1,1
Граничное напряжение, V (при токе эмиттера 0,5 А и длительности импульса 10 мкс), не менее	30	30	30
Время рассасывания, мкс (при токе коллектора 0,5 А, токе базы для группы А - 70 мА, для групп Б, В - 40 мА, частоте 1000 НЗ, длительности импульса 10 мкс и равенстве запирающего и насыщающего токов базы), не более	0,7	0,7	0,7
Время включения, мкс (при токе коллектора 0,5 А, токе базы для группы А - 70 мА, для групп Б, В - 40 мА, частоте 2000 НЗ и длительности импульса 0,5 мкс), не более	0,1	0,1	0,1
Емкость коллекторного перехода, пФ (при напряжении на коллекторе 10 V и частоте 5 МНЗ), не более	50	50	50
Емкость эмиттерного перехода, пФ (при напряжении на эмиттере 0,5 V и частоте 2 МНЗ), не более	250	250	250